COMPARISON OF PARMELA SIMULATION AND MEASURED PARAMETERS ON SCSS PROTOTYPE ACCELERATOR

Toru Hara^{1,A)}, Kazuaki Togawa^{A)}, Takanori Tanikawa^{B)}, Makina Yabashi^{C)}, Hitoshi Tanaka^{C)}, Tsumoru Shintake^{A)},

Hideo Kitamura^{A)} ^{A)} RIKEN/SPring-8 1-1-1 Kouto, Sayo, Hyogo 679-5148 ^{B)} School of Science, University of Hyogo 3-2-1 Kouto, Kamigori, Ako, Hyogo 678-1297 ^{C)} JASRI/SPring-8 1-1-1 Kouto, Sayo, Hyogo 679-5198

Abstract

After the completion of the SCSS (SPring-8 Compact SASE Source) prototype accelerator in autumn 2005, we started the commissioning of the machine in May 2006. One month later, we have succeeded to confirm the amplification of spontaneous radiation. The electron beam parameters have been designed and estimated by PARMELA. The measured beam parameters, after the bunching procedure and emittance degradation due to space charge, show fairly good agreement with the simulation.

PARMELA**による**SCSS**試験加速器のビーム設計と** 実測パラメータの比較

1. はじめに

SPring-8では、0.1 nmを切るX線自由電子レー ザー(X-FEL)計画(SCSS)の実現に向け、250 MeV 試験加速器を建設し、2005年秋からビーム運転を 行っている。ハードウェアや制御系の改良を経て、 2006年5月より本格的なビーム調整を行い、約1ヶ月 でレーザー増幅に成功した。試験加速器のビーム設 計は主にPARMELAを用いて行われ、実際のビームパ ラメータはほぼ設計通りの値を得た。以下SCSS試験 加速器のビーム設計の概要と、得られた測定結果に ついて報告する。

2. 250MeV-SCSS試験加速器の概要

SCSSの大きな特徴の一つは、他国のX-FEL計画が 採用しているRFレーザーフォトカソード電子銃に代 えて、CeB₆単結晶を用いた500kVパルス熱電子銃を用 いている点である^[1]。熱電子銃は、電子ビーム安定 性や維持管理の面でRFフォトカソードに比べ非常に 優れている反面、電子銃からのピーク電流が小さく、 低エネルギー(<1 MeV)でのバンチ圧縮が不可欠 となる。

図1にSCSS試験加速器の構成を示す。電子銃から 出た1Aのマイクロ秒パルスは、下流のdeflectorに よってパルス中心の1ns程度が切り出され、 ϕ 5 mm のピンホールでカソードエッジから放出された外側 の電子を落とした後、238 MHz、476 MHzおよびAPS 型S-band定在波加速管を用いたvelocity bunching によって、RFフォトカソード電子銃とほぼ同等の ピーク電流(約80 A)までバンチ圧縮される。その 後、S-band進行波加速管(TW-S)で約40 MeVまで加 速したところで、バンチコンプレッサー(BC)を用 いた2段目のバンチ圧縮を行い、C-band加速管(C-1 からC-4)で250 MeVまでビームを加速する。

FELにとって最も重要なビームパラメータである スライスエミッタンスとピーク電流は、40 MeVバン チコンプレッサー出口でほぼ決まるため、入射器部 分でいかにエミッタンスを崩さず、高いピーク電流 を得るかがビーム設計の鍵となる。

3. PARMELAによるビーム設計

3.1 初期条件

PARMELAは電子銃部のDC加速を取り扱えないため、 simulationでは仮想のカソード面から、パルス幅1 ns、初期エネルギー500 keVの時間方向に均一な電 子ビーム出射を仮定している。カソード面上の初期 規格化エミッタンスは、 0.5π mm-mradを用いた。 初期のビームサイズと角度発散は、S-band加速管前 の3カ所(図1中(a)、(b)、(c))において、各々 磁気レンズの収束パラメータを変化させて測定した ビームサイズを再現するように合わせている。この ときの3カ所におけるビームサイズの実測値と計算

¹ E-mail: toru@spring8.or.jp



値を、図2に示す。



図2:入射部におけるビームサイズの 実測値(丸点)と計算値(実線)、 各々図1中(a)黒、(b)青、(c)赤における値

3.2 バンチ圧縮

試験加速器におけるエミッタンス劣化の主な要因 は、ビームエネルギーの低い入射器部の空間電荷効 果である。試験加速器では、1 MeV以下のエネル ギー領域のビーム収束系に、離散的な磁気レンズを 採用している。ビーム収束系、およびバンチ圧縮率 を決定するRF電圧と位相のパラメータは、圧縮の過 程で電子銃カソードから出た横方向の均一分布を保 ち、空間電荷効果によるスライスエミッタンスの劣 化を抑えるように設定した。図1に各加速空胴の位 相と、加速器各部におけるエネルギーおよびピーク 電流の計算値を示す。

実際の入射器部におけるvelocity bunchingによるバンチ圧縮は、マイクロ波波長計を用いて測定した^[2]。図3は、S-band定在波加速管(図1中APS)をoffにした時、APS前後のスクリーン(図1(c)と

(d)) における各々476MHzRF位相に対する電子バン チ圧縮率の相対変化を示している。実線はマイクロ 波波長計を用いて測定したバンチ長変化、点線は PARMELAによるピーク電流変化の計算結果である。 マイクロ波波長計は、電子ビームをスクリーンに当 てた時に発生するコヒーレント放射の出力を測定し ているため、バンチ長が短く、ピーク電流が大きく なるほど出力が大きくなる。マイクロ波波長計の出 力は波長に対する感度や非線形性があるため、スク リーン(c)におけるバンチ圧縮最大位相が計算と若 干ずれているが、概ね設計通り位相でバンチ圧縮が 行われていることが確認できる。なお通常のFEL運 転で使用する476MHzの位相は-25°で、APS前半部で バンチ圧縮が最大になるように設定されており、 APSでの加速によってバンチ圧縮をオーバーバンチ ング手前で止めるようにしている。

バンチコンプレッサーを通過した後のバンチ長は、 3、4本目のC-band加速管(図1中C-3とC-4) RFのゼ ロクロスに電子バンチをのせ、バンチ長に応じたエ ネルギー分散をシケイン部(図1(g))で測定する ことにより求めた。測定結果は約1 ps(全幅)で、 計算値約0.7 ps(全幅)より若干長い結果が得られ た。

金ミラーからのOTRを用いたストリークカメラに よるバンチ長測定も試みたが、発光点からカメラま での距離が約8 mと長く、色収差の影響等により得 られたバンチ長は約2 ps (RMS) であった^[3]。

3.3 エミッタンスおよびビームサイズ

試験加速器のビームプロファイルは、蛍光板およ びOTRを用いて加速器各所で測定を行った。図4に、 バンチコンプレッサー中央(図1(e))での水平 ビームプロファイルの測定結果と計算結果を示す。 スクリーンに蛍光板を使用しているため、測定され たプロファイルにはぼやけがあるが、ほぼ計算通り のエネルギー分散によるビーム拡がりが得られてい る。



図3:476 MHz空胴のRF位相に対するマイクロ波波 長計で測定したバンチ長の相対変化(実線)と PARMELAによるピーク電流の変化(点線)、青がAPS 手前(図1(c))、赤がAPS後(図1(d))における 測定および計算結果、476MHzRF位相は0°がクレス トに対応



図4:バンチコンプレッサー中央(図1(e))にお ける水平方向ビームプロファイル、 赤線が実測、青線がPARMELAによる計算

FELにとって重要なスライスエミッタンスは、現 状の試験加速器では正確に測定できないため、エ ミッタンス評価は、四極電磁石の収束力を変化させ るQ-scanによる射影エミッタンス測定によって行っ た。バンチコンプレッサー出口(図1(f))とアン ジュレータ手前(図1(h))で測定した規格化射影 エミッタンス(RMS)と、計算で得られた値を表1に 示す。射影エミッタンスは、スリットの開口や電子 ビーム収束系のエラー等によって変わることを考慮 すると、計算値はかなりよい精度で測定値に一致し ているといえる。

最終的にアンジュレータ手前(図1(h))における、規格化スライスエミッタンスとピーク電流の計算値を図5に示す。現状では、ピーク電流とスライ

スエミッタンスは直接測定できていないが、間接的 にレーザー増幅の電流やアンジュレータK値の依存 性から推定されるビーム輝度(480から630 A/mmmmrad程度)^[4]と計算値(約400 A/mmm-mrad)を比較 すると、ほぼ設計通りのビームパラメータが得られ ていると思われる。

測定場所	測定値	計算値
バンチコンプレッサー	ε _x = 約3π	$\varepsilon_x = 2.8\pi$
出口 (図1 (f))	$\epsilon_{y} = 3\pi$	$\epsilon_{y}=2.6\pi$
アンジュレータ手前	ε _x = 約4π	$\epsilon_x = 2.3\pi$
(図1 (h))	$\epsilon_{y} = 2\pi$	$\epsilon_y = 2.3\pi$
表1・相格化射影エミッタンスの比較		





ライスエミッタンスとバンチ形状、 スライス幅は0.1 ps

4. まとめ

PARMELAのsimulationは、シケイン部のCSR効果が 考慮されていないものの、低エネルギー部での空間 電荷効果やバンチ圧縮の過程は、実際の加速器を比 較的よく再現している。SCSSの8 GeV計画にとって 最も重要な入射器部の性能が、試験加速器において ほぼ設計通り達成できたことは、今後8 GeV計画を 進める上で大きな指針となる。

参考文献

- K. Togawa, et al., "Emittance Measurement on the CeB₆ Electron Gun for the SPring-8 Compact SASE Source", Proceedings of the 2004 FEL Conference, 351-354, URL: http://www.JACoW.org.
- [2] 前坂比呂和 他, "SCSS試験加速器におけるコヒーレント遷移放射を使ったバンチ長測定のためのマイクロ波波長計の開発", in this proceedings.
- [3] 谷川貴紀 他、"SCSS試験加速器におけるフェムト秒ストリークカメラを用いた電子ビームバンチ長測定", in this proceedings.
- [4] 田中均 他, "SCSS試験加速器のビーム性能", in this proceedings.